## (12) 特許公報(B2)

(11)特許番号

## 特許第6976711号

(P6976711)

(45) 発行日 令和3年12月8日(2021.12.8)

(19) 日本国特許庁(JP)

- (24) 登録日 令和3年11月12日 (2021.11.12)
- (51) Int.Cl. F I A 6 1 B 5/055 (2006.01) A 6 1 B 5/055 3 1 1 G 0 1 N 24/08 (2006.01) G 0 1 N 24/08 5 2 0 L G 0 1 N 24/08 5 2 0 Y

請求項の数 10 (全 17 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日 (65) 公開番号	特願2017-90449 (P2017-90449) 平成29年4月28日 (2017.4.28) 特開2018-186942 (P2018-186942A)	(73)特許権者	音 594164542 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 栃木県大田原市下石上1385番地
(43) 公開日	平成30年11月29日 (2018.11.29)	(74) 代理人	100108855
審査請求日	令和2年2月27日 (2020.2.27)		弁理士 蔵田 昌俊
		(74)代理人	100103034
			弁理士 野河 信久
		(74)代理人	100075672
			弁理士 峰 隆司
		(74) 代理人	100153051
			弁理士 河野 直樹
		(74)代理人	100179062
			弁理士 井上 正
		(74)代理人	100189913
			弁理士 鵜飼 健
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】磁気共鳴イメージング装置及びパルス設計方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

被検体を含む撮像領域内のB<sub>1</sub>感度マップの逆特性を算出する第1算出部と、

多次元の多項式関数を前記B<sub>1</sub>感度マップの逆特性にフィッティングさせるフィッティング部と、

フィッティングさせた前記多項式関数と、RFパルスとk空間との関係式とを関連づけ ることにより、前記RFパルスの前記k空間上での位置、振幅及び位相を算出する第2算 出部と、

前記位置、前記振幅及び前記位相に従い、前記RFパルスの印加を制御する制御部と、 を具備し、

10

前記多項式関数と前記関係式とは次元が一致する磁気共鳴イメージング装置。

【請求項2】

前記関係式は、複数のRFパルスを設計するために前記 k 空間上に分散配置される複数 の Spokeを表し、

前記制御部は、複数のRFパルスを、前記複数のSpokeを結ぶトラジェクトリに沿った順序で印加する請求項1に記載の磁気共鳴イメージング装置。

【請求項3】

前記フィッティング部は、前記被検体の撮像部位に応じて、フィッティングさせるべき 多項式関数を選択する請求項1又は請求項2に記載の磁気共鳴イメージング装置。 【請求項4】 前記多項式関数は、2次の関数であり、

前記第2算出部は、前記2次の関数に基づく2次曲線の焦点および軸に基づいて、前記 位置及び前記位相を算出する請求項1乃至3のいずれか1項に記載の磁気共鳴イメージン グ装置。

(2)

【請求項5】

前記Spokeの1つは、少なくとも前記k空間の原点に位置し、

前記第2算出部は、前記原点に位置するSpokeに対応するRFパルスの振幅が負に ならないように条件式を設定する請求項2に記載の磁気共鳴イメージング装置。

【請求項6】

10 前記第2算出部は、前記関係式における位相が零度よりも閾値以上ずれる場合、当該関 係式の近似方法を変更する請求項1乃至5のいずれか1項に記載の磁気共鳴イメージング 装置。

【請求項7】

前記第2算出部は、前記撮像部位に関する B1の強度分布が対称性を有する場合であり 、かつ前記多項式関数が下に凸となる場合、前記関係式に含まれる位相を ずらす請求項 3に記載の磁気共鳴イメージング装置。

【請求項8】

前記制御部は、第1のRFパルスの振幅を複数のRFパルスの振幅の総和で除算した値 と、所望のフリップ角とを乗算し、当該第1のRFパルスによるフリップ角を算出する請 求項1乃至7のいずれか1項に記載の磁気共鳴イメージング装置。

【請求項9】

前記被検体に関する情報を含む撮像条件と前記関係式との対応関係を示すテーブルを格 納する格納部をさらに具備し、

前記第2算出部は、前記テーブルを参照して、撮像対象の被検体に応じた前記関係式を 決定する請求項1乃至3のいずれか1項に記載の磁気共鳴イメージング装置。

【請求項10】

被検体を含む撮像領域内のBュ感度マップの逆特性を算出し、

多次元の多項式関数を前記 B ₁ 感度マップの逆特性にフィッティングさせ、

フィッティングさせた前記多項式関数と、RFパルスとk空間との関係式とを関連づけ

ることにより、前記RFパルスの前記k空間上での位置、振幅及び位相を算出し、 前記多項式関数と前記関係式とは次元が一致するパルス設計方法。

【発明の詳細な説明】

- 【技術分野】
- [0001]

本発明の実施形態は、磁気共鳴イメージング装置及びパルス設計方法に関する。

【背景技術】

[0002]

磁気共鳴イメージング装置では、ムラのないMR画像を得るために、均一な磁化の分布 が得られることが重要である。しかし、測定対象及びコイルの影響により、高周波磁場の 空間分布、すなわちRF(Radio Freguency)コイルの感度マップ(以下 、B┐感度マップ)にムラが生じ、磁場が不均一となる場合がある。

[0003]

磁場の不均一性を解消するため、RFパルスの振幅及び位相が適切に制御されることで 、 B 1 感度マップに強度分布(以下、 B 1 マップ設計値)が重畳される。 B 1 マップ設計 値がBュ感度マップの逆特性になるようにRFパルスが適切に制御されることで、Bュマ ップ設計値とB1感度マップとの積で得られる磁化の分布が均一になる。 [0004]

B,マップ設計値の計算方法としては、例えばSTA(Small Tip e)近似と呼ばれる線形近似に基づく方法がある。測定対象である被検体又は被検体の部 位によって高周波磁場B」の不均一性が様々に変化するため、STA近似を用いて印加す

50

Angl

20

30

10

20

30

40

50

す	る	0																																					
ľ	义	面	Ø	簡	単	な	説	明	]																														
ľ	0	0	0	8	]																																		
ľ	义	1	]	本	実	施	形	態	に	係	る	磁	気	共	鳴	イ	メ	_	ジ	ン	グ	装	置	Ø	構	成	を	示	す	ブ		ッ	ク	义。	D				
ľ	义	2	]	本	実	施	形	態	で	想	定	す	る	В	1	感	度	マ	ッ	プ	Ø	不	均	_	性	Ø	改	善	手	法	を	示	す	概	念日	図。			
ľ	义	3	]	本	実	施	形	態	に	係	る	磁	気	共	鳴	イ	メ	_	ジ	ン	グ	装	置	Ø	撮	像	処	理	を	示	す	フ		_	チ・	r -	- ト		
ľ	义	4	]	ス	テ	ッ	プ	S	3	0	5	に	示	す	S	р	о	k	e	の	決	定	処	理	を	示	す	フ		_	チ	ヤ	_	۲.	D				
ľ	义	5	]	k	空	間	F	Ø	S	р	о	k	e	Ø	位	· 置	<sub>ກ</sub>	—	例	を	示	す	义	0															
ľ	义	6	]	k	空	間	F	Ø	S	р	о	k	e	Ø	۲	ラ	ジ	т	ク	۲	IJ	を	示	す	义	0													
ľ	义	7	]	义	6	Ø	۲	ラ	ジ	I	ク	۲	IJ	に	沿	っ	た	送	信	パ	ル	ス	<sub>ກ</sub>	_	例	を	示	す	义	0									
ľ	义	8	А	]	頭	部	の	В	1	感	度	マ	ッ	プ	Ø		例	を	示	す	义	0																	
ľ	义	8	В	]	腹	部	の	В	1	感	度	マ	ッ	プ	Ø		例	を	示	す	义	0																	
ľ	义	9	А	]	S	р	о	k	e	適	用	前	の	腹	部	<sub>ກ</sub>	В	1	感	度	マ	ッ	プ	Ø	—	例	を	示	す	义	0								
ľ	义	9	В	]	S	р	о	k	e	適	用	後	Ø	В	1	感	度	र र	ッ	プ	<sub>ກ</sub>	—	例	を	示	す	义	0											
ľ	発	明	を	実	施	す	る	た	め	Ø	形	態	]																										
ľ	0	0	0	9	]																																		
	以	下	、	添	付	义	面	を	用	L١	τ	、	本	実	施	形	態	に	係	る	磁	気	共	鳴	イ	ኦ	_	ジ	ン	グ	装	置	及	び	パノ	レフ	て訳	計	
方	法	を	詳	細	に	誽	明	す	る	0	な	お	、	以	下	<sub>ກ</sub>	誽	明	に	お	ı١	τ	、	略	同	—	<sub>ກ</sub>	機	能	及	び	構	成	を	有了	する	5 構	成	
要	素	に	っ	ι١	τ	は	、	同	—	符	号	を	付	し		重	複	説	明	は	必	要	な	場	合	に	<sub>ກ</sub>	み	行	う	0								
ľ	0	0	1	0	]																																		
	义	1	を	用	ι١	τ	、	本	実	施	形	態	に	係	3	磁	気	共	鳴	イ	ኦ	_	ジ	ン	グ	(	М	а	g	n	e	t	i	с		гe	e s	0	
n	а	n	с	e		i	m	а	g	i	n	g	:	以	下		Μ	R	Ι	と	呼	ιSŇ	)	装	置	Ø	構	成	に	っ	L١	τ	説	明	する	3.	义	1	
は	、	本	実	施	形	態	に	係	る	Μ	R	Ι	装	置	1	0	0	Ø	構	成	を	示	す	义	で	あ	る	0											
ľ	0	0	1	1	]																																		
	同	义	に	示	す	よ	う	に	、	本	実	施	形	態	に	係	る	Μ	R	Ι	装	置	1	0	0	は	、	静	磁	場	磁	石	1	0	1 0	と、	傾	斜	
磁	場	コ	1	ル	1	0	3	と	、	傾	斜	磁	場	電	源	1	0	5	と	、	寝	台	1	0	7	と	、	寝	台	制	御	回	路	1	0	98	Ξ、	送	
信	コ	1	ル	1	1	3	と	、	送	信	回	路	(	送	信	部	)	1	1	5	と	、	受	信	コ	1	ル	1	1	7	と	、 !	受	信	回足	络(	(受	信	
部	)	1	1	9	と	、	シ	_	ケ	ン	ス	制	御	回	路	(	シ	_	ケ	ン	ス	制	御	部	)	1	2	1	と	、	バ	ス	1	2	3 0	と、	1	ン	
タ	フ	т	_	ス	回	路	(	λ	力	部	)	1	2	5	٤		デ	1	ス	プ	レ	イ	(	表	示	部	)	1	2	7	と	、	記	憶	装置	置(	(記	!憶	

べきRFパルスの設計指針を立てる際には、撮像する対象に最適な設計手法が必要となる

発明が解決しようとする課題は、B」感度マップの不均一性を簡易かつ高精度に改善す

本実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置は、第1算出部と、フィッティング部と、 第2算出部と、制御部とを含む。第1算出部は、被検体を含む撮像領域内のBュ感度マッ プの逆特性を算出する。フィッティング部は、多次元の多項式関数を前記Bュ感度マップ の逆特性にフィッティングさせる。第2算出部は、フィッティングさせた前記多項式関数 と、RFパルスとk空間との関係式とを関連づけることにより、前記RFパルスの前記k 空間上での位置、振幅及び位相を算出する。制御部は、前記位置、前記振幅及び前記位相

に従い、前記RFパルスの印加を制御する。前記多項式関数と前記関係式とは次元が一致

【特許文献1】米国特許出願公開2002/0161766号公報

【特許文献2】米国特許第7701211号明細書

【先行技術文献】 【特許文献】 [0005]

【発明の概要】

[0006]

ることにある。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

【課題を解決するための手段】

(3)

10

部)129と、処理回路(処理部)131とを備える。なお、MRI装置100は、静磁 場磁石101と傾斜磁場コイル103との間において中空の円筒形状のシムコイルを有し ていてもよい。

【0012】

静磁場磁石101は、中空の円筒、形状に形成された磁石であり、内部の空間に一様な 静磁場(B<sub>0</sub>)を発生する。この静磁場磁石101としては、例えば、超伝導磁石等が使 用される。なお、不図示のシムコイルが、静磁場磁石101の内側において中空の円筒形 状に形成されてもよい。シムコイルは、不図示のシムコイル電源に接続され、シムコイル 電源から供給される電源により、静磁場磁石101により発生された静磁場を均一化する

[0013]

傾斜磁場コイル103は、中空の円筒形状に形成されたコイルであり、静磁場磁石10 1の内側に配置される。傾斜磁場コイル102は、互いに直交するX、Y、Zの各軸に対応する3つのコイルが組み合わされて形成される。Z軸方向は、静磁場と同じ方向である とする。また、Y軸方向は、鉛直方向とし、X軸方向は、Z軸及びY軸に垂直な方向とす る。傾斜磁場コイル102における3つのコイルは、傾斜磁場電源105から個別に電流 供給を受けて、X、Y、Zの各軸に沿って磁場強度が変化する傾斜磁場を発生させる。 【0014】

ここで、傾斜磁場コイル102によって発生するX、Y、Z各軸の傾斜磁場は、例えば 、スライス選択用傾斜磁場、位相エンコード用傾斜磁場及び周波数エンコード用傾斜磁場 20 (リードアウト傾斜磁場ともいう)にそれぞれ対応している。スライス選択用傾斜磁場は 、任意に撮像断面を決めるために利用される。位相エンコード用傾斜磁場は、空間的位置 に応じて磁気共鳴(Magnetic resonance:以下、MRと呼ぶ)信号の 位相を変化させるために利用される。周波数エンコード用傾斜磁場は、空間的位置に応じ てMR信号の周波数を変化させるために利用される。

[0015]

傾斜磁場電源105は、シーケンス制御回路121の制御により、傾斜磁場コイル10 3に電流を供給する電源装置である。

【0016】

寝台107は、被検体Qが載置される天板1071を備えた装置である。寝台107は 30 、寝台制御回路109による制御のもと、被検体Qが載置された天板1071を、ボア1 11内へ挿入する。通常、寝台107は、長手方向が静磁場磁石101の中心軸と平行に なるように、本MRI装置100が設置された検査室内に設置される。

【0017】

寝台制御回路109は、寝台107を制御する回路であり、例えばプロセッサにより実 現される。寝台制御回路109は、インタフェース回路125を介した操作者の指示によ り寝台107を駆動し、天板1071を長手方向及び上下方向へ移動する。

【0018】

送信コイル113は、傾斜磁場コイル103の内側に配置されたRF(Radio F requency)コイルである。送信コイル113は、送信回路115から高周波パル <sup>40</sup> ス(RFパルス)の供給を受けて、高周波磁場に相当する送信RF波を発生する。送信コ イルは、例えば、全身用コイル(whole body coil:WBコイル)である 。WBコイルは、送受信コイルとして使用されてもよい。WBコイルと傾斜磁場コイル1 03との間には、これらのコイルを磁気的に分離するための円筒状のRFシールドが設置 される。

【0019】

送信回路115は、シーケンス制御回路121の制御により、ラーモア周波数に対応す る高周波パルスを送信コイル113に供給する。具体的には、送信回路115は、発振部 、位相選択部、周波数変換部、振幅変調部、高周波電力増幅部等を有する。発振部は、静 磁場中における対象原子核に固有の共鳴周波数の高周波信号を発生する。位相選択部は、

上記高周波信号の位相を選択する。周波数変換部は、位相選択部から出力された高周波信号の周波数を変換する。振幅変調部は、周波数変調部から出力された高周波信号の振幅を 例えばsinc関数に従って変調する。高周波電力増幅部は、振幅変調部から出力された 高周波信号を増幅する。これらの各部の動作の結果として、送信回路115は、ラーモア 周波数に対応する高周波パルスを送信コイル113に出力する。

(5)

[0020]

受信コイル117は、傾斜磁場コイル103の内側に配置されたRFコイルであり、高 周波磁場によって被検体Qから放射されるMR信号を受信する。受信コイル117は、受 信したMR信号を受信回路119へ出力する。受信コイル117は、例えば、1以上、典 型的には複数のコイルエレメントを有するコイルアレイである。なお、図1において送信 コイル113と受信コイル117とは別個のRFコイルとして記載されているが、送信コ イル113と受信コイル117とは、一体化された送受信コイルとして実施されてもよい 。送受信コイルは、例えば、被検体Qの撮像対象に対応し、頭部コイルのような局所的な 送受信RFコイルである。

[0021]

受信回路119は、シーケンス制御回路121の制御により、受信コイル117から出 力されたMR信号に基づいて、デジタル化された複素数データである磁気共鳴データ(以 下、MRデータと呼ぶ)を生成する。具体的には、受信回路119は、受信コイル117 から出力されたMR信号に対して、前置増幅、中間周波変換、位相検波、低周波増幅、フ ィルタリング等の各種信号処理を施した後、各種信号処理が施されたデータに対してアナ ログ/デジタル(A/D(Analog to Digital))変換を実行する。受 信回路119は、AD変換されたデータに対して標本化(サンプリング)を実行する。こ れにより、受信回路119は、MRデータを生成する。受信回路119は、生成したMR データを、シーケンス制御回路121に出力する。受信回路119により生成されたMR

[0022]

シーケンス制御回路121は、処理回路131から出力されたパルスシーケンス情報に 従って、傾斜磁場電源105、送信回路115及び受信回路119を制御し、被検体Qに 対する撮像を行う。パルスシーケンス情報には、傾斜磁場電源105により傾斜磁場コイ ル103に供給される電流の大きさ、傾斜磁場電源105により電流が傾斜磁場コイル1 03に供給されるタイミング、送信回路115により送信コイル113に供給されるRF パルスの大きさ、送信回路115により送信コイル113にRFパルスが供給されるタイ ミング、受信回路119によりMR信号が受信されるタイミング等が定義される。傾斜磁 場電源105により傾斜磁場コイル103に供給される電流の大きさは、パルスシーケン スに応じた傾斜磁場の波形に対応する。

【0023】

バス123は、インタフェース回路125と、ディスプレイ127と、記憶装置129 と、処理回路131との間でデータが伝送する伝送路である。バス123には、ネットワ ーク等を介して、各種生体信号計測器、外部記憶装置等が適宜接続されてもよい。 【0024】

インタフェース回路125は、操作者からの各種指示や情報入力を受け付ける回路であ る。インタフェース回路125は、例えば、マウス等のポインティングデバイス、あるい はキーボード等の入力デバイスに関する回路である。なお、インタフェース回路125は 、マウス、キーボード等の物理的な操作部品に関する回路に限定されない。例えば、本M RI装置100とは別体に設けられた外部の入力機器から入力操作に対応する電気信号を 受け取り、受け取った電気信号を種々の回路へ出力するような電気信号の処理回路もイン タフェース回路125の例に含まれる。

【0025】

ディスプレイ127は、処理回路131におけるシステム制御機能1311による制御のもとで、画像生成機能1315により再構成されたMR画像等の各種の情報を表示する

10

20

30

40

。ディスプレイ127は、例えば、CRTディスプレイや液晶ディスプレイ、有機ELデ ィスプレイ、LEDディスプレイ、プラズマディスプレイ、又は当技術分野で知られてい る他の任意のディスプレイ、モニタ等の表示デバイスである。

(6)

【0026】

記憶装置129は、データ配列機能1313を介して k 空間に配列された M R データ、 画像生成機能1315により生成された画像データ等を記憶する。記憶装置129は、各 種撮像プロトコル、撮像プロトコルを規定する複数の撮像パラメータを含む撮像条件等を 記憶する。記憶装置129は、処理回路131で実行される各種機能に対応するプログラ ムを記憶する。記憶装置129は、例えば、R A M (R a n d om A c c e s s M e mory)、フラッシュメモリ等の半導体メモリ素子、ハードディスクドライブ(h a r d d i s k d r i v e)、ソリッドステートドライブ(s o l i d s t a t e d r i v e)、光ディスク等である。また、記憶装置129は、CD-ROMドライブやD VDドライブ、フラッシュメモリ等の可搬性記憶媒体との間で種々の情報を読み書きする 駆動装置等であってもよい。

【0027】

処理回路131は、ハードウェア資源として図示していないプロセッサ、ROMやRA M等のメモリ等を有し、本MRI装置100を総括的に制御する。処理回路131は、シ ステム制御機能1311、データ配列機能1313、画像生成機能1315、逆特性算出 機能1317、関数決定機能1319及びSpoke(スポーク)算出機能1321を有 する。システム制御機能1311、データ配列機能1313、画像生成機能1315、逆 特性算出機能1317、関数決定機能1319及びSpoke(気ポーク)算出機能1321を有 れる各種機能は、コンピュータによって実行可能なプログラムの形態で記憶装置129へ 記憶されている。処理回路131は、これら各種機能に対応するプログラムを記憶装置1 29から読み出し、実行することで各プログラムに対応する機能を実現するプロセッサで ある。換言すると、各プログラムを読みだした状態の処理回路131は、図1の処理回路 131内に示された各機能を有する。

[0028]

なお、図1においては単一の処理回路131にてこれら各種機能が実現されるものとし て説明したが、複数の独立したプロセッサを組み合わせて処理回路131を構成し、各プ ロセッサがプログラムを実行することにより機能を実現するものとしても構わない。換言 すると、上述のそれぞれの機能がプログラムとして構成され、1つの処理回路が各プログ ラムを実行する場合であってもよいし、特定の機能が専用の独立したプログラム実行回路 に実装される場合であってもよい。なお、処理回路131が有するシステム制御機能13 11、データ配列機能1313、画像生成機能1315、逆特性算出機能1317、関数 決定機能1319及びSpoke算出機能1321は、それぞれ制御部、データ配列部、 画像生成部、第1算出部、フィッティング部及び第2算出部の一例である。 【0029】

上記説明において用いた「プロセッサ」という文言は、例えば、CPU(Centra l Processing Unit)、GPU(Graphical Process ing Unit)或いは、特定用途向け集積回路(Application Spec ific Integrated Circuit:ASIC)、プログラマブル論理デ バイス(例えば、単純プログラマブル論理デバイス(Simple Programma ble Logic Device:SPLD)、複合プログラマブル論理デバイス(C omplex Programmable Logic Device:CPLD)、及 びフィールドプログラマブルゲートアレイ(Field Programmable G ate Array:FPGA))等の回路を意味する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ 

プロセッサは、記憶装置129に保存されたプログラムを読み出し実行することで機能 を実現する。なお、記憶装置129にプログラムを保存する代わりに、プロセッサの回路 内にプログラムを直接組み込むよう構成しても構わない。この場合、プロセッサは、回路

10

20



40

30

50

内に組み込まれたプログラムを読み出し実行することで機能を実現する。なお、寝台制御 回路109、送信回路115、受信回路119、シーケンス制御回路121等も同様に、 上記プロセッサ等の電子回路により構成される。

【0031】

処理回路131は、システム制御機能1311により、MRI装置100を統括的に制 御する。具体的には、処理回路131は、記憶装置129に記憶されているシステム制御 プログラムを読み出してメモリ上に展開し、展開されたシステム制御プログラムに従って 本MRI装置100の各回路を制御する。

[0032]

次に、本実施形態で想定する B<sub>1</sub>感度マップの不均一性の改善手法について図 2の概念 <sup>10</sup> 図を参照して説明する。

【0033】

ー般にB<sub>1</sub>分布の設計段階では、設計B<sub>1</sub>分布(a)のように、撮像領域においてB<sub>1</sub> 分布が均一となるように設計される。しかし実際には、グラデーションで示すようなRF コイルの感度ムラや人体による磁場への影響(b)がある。よって、実際にRFコイルで 取得される受信コイルの空間感度を示すB<sub>1</sub>感度マップとしては、設計B<sub>1</sub>分布(a)と 磁場への各影響(b)とがピクセル毎に重畳され、不均一な取得B<sub>1</sub>感度マップ(c)が 取得されることになる。

【0034】

そこで、 B<sub>1</sub>分布に強度分布を重畳させ、不均一な B<sub>1</sub>感度マップ( c )の逆特性に対 <sup>20</sup> 応する設計 B<sub>1</sub>分布( d )を生成することができれば、設計 B<sub>1</sub>分布( d )と磁場への各 影響( b )とが重畳されることで、磁場への影響( b )が相殺されうる。結果として、 M R I 装置は、均一な取得 B<sub>1</sub>感度マップ( e )を取得できる。

【 0 0 3 5 】

しかし、B<sub>1</sub>感度マップ(c)の逆特性は理論的に計算できるものの、B<sub>1</sub>感度マップ (c)の逆特性に対応する設計B<sub>1</sub>分布(d)を、実際に送信コイルから発生するRFパ ルスで実現することは難しい。

【0036】

そこで、本実施形態に係るMRI装置は、B<sub>1</sub>感度マップの逆特性を表す多項式関数と 、RFパルスとk空間との関係式(本実施形態ではSpokeの関係式)とを関連づける ことにより、Spoke技術で使用する、RFパルスのパラメータ(k空間上の位置、振 幅及び位相)を算出する。つまり、算出されたk空間上の位置、振幅及び位相に基づいて RFパルスが印加されることで、B<sub>1</sub>感度マップの逆特性に高精度に近似した設計B<sub>1</sub>分 布を実際のRFパルスで生成することができ、MRI装置は、磁場への各影響が相殺され た、均一なB<sub>1</sub>感度マップを得ることができる。

【 0 0 3 7 】

以下、本実施形態に係るMRI装置による撮像処理について、図3のフローチャートを 参照して説明する。

[0038]

ステップS301では、撮像条件が設定される。例えば、インタフェース回路125を 40 介して入力された操作者の指示に基づき、処理回路131が、記憶装置129に記憶され る撮像条件を読み出して撮像条件を設定すればよい。撮像条件としては、例えば、被検体 の撮像部位、撮像時間及びコントラスト等が設定されればよい。

【 0 0 3 9 】

ステップS302では、位置決めスキャンが実行される。位置決めスキャンは、本撮像 の位置決めのために用いられる位置決め画像を生成するために実行される撮像プロトコル によるスキャンである。具体的には、シーケンス制御回路121は、位置決めスキャン用 の撮像プロトコルに従って、撮像対象に対して位置決め撮像を実行する。処理回路131 は、画像生成機能1315により、位置決め撮像によるMRデータに基づいて位置決め画 像を生成する。 [0040]

ステップS303では、位置決めスキャンにより発生した位置決め画像上に撮像領域が 設定される。具体的には、例えば、インタフェース回路125を介した操作者の指示によ り、本撮像における撮像位置が入力される。撮像位置の入力により撮像領域が決定される

(8)

【0041】

ステップS304では、撮像領域に対してB<sub>1</sub>感度マップを取得するためのプリスキャンが実行され、B<sub>1</sub>感度マップが取得される。具体的には、シーケンス制御回路121は、B<sub>1</sub>感度マップを取得するためのプリスキャン用のパルスシーケンスと撮像領域とに従って、傾斜磁場電源105及び各種回路を制御し、被検体に対して撮像を行う。処理回路131は、画像生成機能1315により、収集されたMRデータに基づいて、撮像領域におけるB<sub>1</sub>感度マップを生成する。B<sub>1</sub>感度マップは、2次元座標空間(×y平面)で表現され、各ピクセルにおいて画素値を有する。

【0042】

なお、同一の被検体に対して連続して撮像する等、 B<sub>1</sub> 感度マップの変化が少ないと考えられる場合は、以前に 1 度撮像した B<sub>1</sub> 感度マップを用い、ステップ S 3 0 4 が省略されてもよい。

【0043】

ステップS305では、処理回路131は、Spoke算出機能1321により、B<sub>1</sub> 感度マップに基づいてSpokeを決定し、Spokeに対応するRFパルスのk空間上 20 での位置とRFパルスの振幅及び位相とを算出する。

【0044】

ステップS306では、 k 空間上での位置、振幅及び位相に基づいて、 Spokeのト ラジェクトリに沿った順序で R F パルスが印加される送信パルスが生成されて、本スキャ ンであるデータ収集シーケンスに組み込まれてデータ収集が実行される。具体的には、処 理回路131が、制御機能1311により、 Spokeを用いた本スキャン用の撮像プロ トコルと撮像領域とに従い、後述する Spokeのトラジェクトリに沿って、 R F パルス が印加されるようにシーケンス制御回路121を制御することで、本スキャンを実行する 。なお、 Spokeの決定方法及び Spokeに基づく印加方法の詳細については後述す る。

[0045]

ステップS307では、本スキャンであるデータ収集シーケンスで生じたMR信号が、 MRデータとして収集され、MR画像が生成される。具体的には、処理回路131は、画 像生成機能1315により、収集されたMRデータに基づいてMR画像を生成する。以上 で撮像処理が終了する。

ここで本スキャンであるデータ収集シーケンスは、FE(Field Echo)法( または、GRE(Gradient Echo)法とも呼ぶ)やSE(Spin Ech o)法、FSE(Fast Spin Echo)法といったMRIで用いられる様々な 撮像パルスシーケンスを示し、Spoke技術で設計された本送信パルスは、少なくとも このデータ収集シーケンスの一部の送信パルスとして用いられて、それより得られたデー タより画像生成がなされることになる。

[0046]

次に、図3のステップS305に示すSpokeの決定処理について図4のフローチャートを参照して説明する。

[0047]

ステップS401では、処理回路131が、逆特性算出機能1317により、被検体Q を含めた撮像領域内のB<sub>1</sub>感度マップの逆特性を取得する。B<sub>1</sub>感度マップの逆特性は、 例えば、B<sub>1</sub>感度マップの各座標値(画素値)の逆数を計算することにより算出する等、 一般的な手法により算出されればよい。

[0048]

10

30

ステップS402では、処理回路131が、関数決定機能1319により、B<sub>1</sub>感度マップの逆特性にフィッティングする。ここでは2次元の多項式関数をフィッティングに用いる。「フィッティングする」とは、例えば、以下の式(1)に示される多項式関数Pの係数及び定数の値を決定することである。つまり、B<sub>1</sub>感度マップの逆特性を多項式関数Pで表現する。

【0049】 【数1】

$$P = ax^{2} + by^{2} + cx + dy + exy + f$$
 (1)

[0050]

x , y は、 B <sub>1</sub> 感度マップの x y 平面における x 方向及び y 方向のピクセル位置を示す 10 。

)

各係数(a,b,c,d,e)及び定数fの値は、B<sub>1</sub>感度マップの逆特性における座標 値を式(1)に代入して求めればよく、例えば、B<sub>1</sub>感度マップがn×nピクセルで表さ れるとすると、以下の式(2)の行列を演算することにより決定すればよい。 【0051】

【数 2 】

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^2 & y_1^2 & x_1 & y_1 & x_1y_1 & 1 \\ x_2^2 & y_2^2 & x_2 & y_2 & x_2y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \\ x_n^2 & y_n^2 & x_n & y_n & x_ny_n & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}$$
(2)

20

30

【0052】

ここで、 p<sub>i</sub> ( i = 1,..., n ) は、 B<sub>1</sub> 感度マップの逆特性の各座標 ( x<sub>i</sub> , y<sub>i</sub> ) の 画素値である。

ステップS403では、処理回路131が、Spoke算出機能1321により、ステップS402においてフィッティングにより係数が決定された多項式関数PとSpokeの関係式(ここでは2次式)とを関連づけ、多項式関数Pを用いてSpokeの関係式を解析的に解く。

【0053】

Spokeは、コサイン関数の重ね合わせで表すことができ、 k 空間上の Spoke位 置に関する図 5の表記に従うと、以下の式(3)のように 2 次式で置き換えることができ る。

$$q(x, y) = A_{1} + 2A_{4} \{\cos(2\pi k_{04}x + 2\pi k_{14}y + \phi_{4})\} + 2A_{5} \{\cos(2\pi k_{05}x + 2\pi k_{15}y + \phi_{5})\}$$

$$\approx -4\pi^{2} (k_{04}^{2}A_{4} + k_{05}^{2}A_{5})x^{2} - 4\pi^{2} (k_{14}^{2}A_{4} + k_{15}^{2}A_{5})y^{2} - 4\pi (k_{04}\phi_{4}A_{4} + k_{05}\phi_{5}A_{5})x - 4\pi (k_{14}\phi_{4}A_{4} + k_{15}\phi_{5}A_{5})y$$

$$-8\pi^{2} (k_{04}k_{14}A_{4} + k_{05}k_{15}A_{5})xy + (A_{1} + 2A_{4} + 2A_{5} - A_{4}\phi_{4}^{2} - A_{5}\phi_{5}^{2})$$
40

(3)

[0055]

よって、処理回路131が、Spoke算出機能1321により、多項式関数PとSp okeの関係式とを関連づけて、Spokeの関係式を解析的に解くことで、RFパルス に関するパラメータであるk空間上の位置(k<sub>x</sub>,k<sub>y</sub>)、振幅及び位相(A<sub>n</sub>, <sub>n</sub>) を一意に決定される。

【0056】

なお、処理回路131は、多項式関数PとSpokeの関係式とを解析的に解くことに 50

限らず、近似的に解いてもよい。

【0057】

次に、 Spoke技術を用いた RFパルスの印加方法の一例について、図6及び図7を 参照して説明する。

【0058】

Spoke技術は、k空間上に分散配置されたスライス選択パルスによって生成可能な B<sub>1</sub>分布により、B<sub>1</sub>分布の不均一性を抑制する技術である。フリップ角が小さいとき、 STA(Small Tip Angle)近似により、横磁化は、磁化ベクトルの大き さM<sub>0</sub>を用いて線形近似できる。これにより、プロッホ方程式を簡易化できるため、k空 間と実空間とをフーリエ変換対として考えることができる。

【 0 0 5 9 】

図6は、 k 空間上の S p o k e のトラジェクトリを示す。 S p o k e 技術では、 k 空間 上に k z 軸に平行なインパルス(デルタ関数)の線(k x - k y 平面で見れば点)があり 、この線を S p o k e とも呼ぶ。図6の例では、5本の S p o k e 6 0 1 があり、「開始 」の位置から「終了」の位置まで、トラジェクトリ602に沿って各 S p o k e 6 0 1 が 結ばれる(選択される)。トラジェクトリ602は、 k x 軸、 k y 軸及び k z 軸により表 現される k 空間上の S p o k e 6 0 1 の位置、及び S p o k e 6 0 1 に対応する R F パル スの印加順序を示す軌跡である。

各 Spoke601には、各 Spoke601のk空間上の位置に対応する R F パルス のパラメータ(振幅及び位相)が対応付けられる。各 Spoke601に対応する振幅及 <sup>20</sup> び位相を有する R F パルスは、サブパルスとして印加される。すなわち、複数個のサブパ ルス全体として1つの励起パルスとなるように R F パルスが設計される。なお、 Spok e技術を単に Spokeと呼ぶこともある。

[0060]

なお、図6の例では、5本のSpokeを用いる例を示すが、これに限らず、オフセットに用いるk空間上の原点のSpokeを含む、3本以上のSpoke601であってもよい。

【0061】

なお、Spoke601の本数が多ければ、その分印加すべきサブパルスの数が増加し 、励起パルスとなるまでに時間がかかるため、撮像時間を考慮して適宜Spoke601 の本数が設定されればよい。

30

10

【 0 0 6 2 】

次に、図6に示すSpoke601のトラジェクトリ602にそった、送信パルスの一例を図7に示す。

【0063】

図7の各グラフは、上から順に、RFパルスの振幅、z方向の傾斜磁場Gz、x方向の 傾斜磁場Gx及びy方向の傾斜磁場Gyを示す。各グラフ共に、縦軸が強度、横軸が時間 である。傾斜磁場Gzはスライス選択用傾斜磁場に、及び傾斜磁場Gxは周波数エンコー ド用傾斜磁場に、及び傾斜磁場Gyは位相エンコード用傾斜磁場にそれぞれ対応している 。スライス選択用傾斜磁場は、任意に撮像断面を決めるために利用される。位相エンコー ド用傾斜磁場は、空間的位置に応じてMR信号の位相を変化させるために利用される。周 波数エンコード用傾斜磁場は、空間的位置に応じてMR信号の周波数を変化させるために 利用される。

【0064】

Spoke601のトラジェクトリ602に沿って、各Spokeに対応したRFパルスを印加できるように傾斜磁場G×、Gy及びGzを掛けつつ、各RFパルスをサブパルスとして印加されればよい。なお、以下では、例えばシステム制御機能1311の制御に基づいて、シーケンス制御回路121がRFパルスの印加を制御すればよい。

【0065】

具体的に、Spokeを用いたパルスシーケンスによるRFパルスの印加について、図 50

6及び図7の例を参照して説明する。まず、「開始」の位置から1つ目のSpokeについて、傾斜磁場Gzを掛けながら、1つ目のSpokeに対応する位相及び振幅でRFパルスが1つ目のサブパルスとして印加される。

【 0 0 6 6 】

1つ目のサブパルスが印加された後、正の値の傾斜磁場G×をかける。その後、負の値の傾斜磁場Gzを掛けながら、2つ目のSpokeに対応する位相及び振幅でRFパルスが2つ目のサブパルスとして印加される。これにより、本実施形態に係るMRI装置は、図6のSpoke601のトラジェクトリ602に沿ってRFパルスを印加することができる。

[0067]

このように、傾斜磁場G×及び傾斜磁場Gyを掛けてトラジェクトリに沿って k 空間を 移動しつつ、傾斜磁場Gzを掛けながら3つ目及び4つ目のSpokeに対応するRFパ ルスを印加する。最後に、 k 空間の k<sub>x</sub> - k<sub>y</sub> 平面の原点に戻り、5つ目のSpokeに 対応するRFパルスを印加すればよい。

[0068]

なお、図7では、傾斜磁場Gzにおいてリワインダを掛けることで、3次元k空間の原 点に移動するように設定しているが、必須ではない。GzのリワインダはGzの1パルス の面積の約50%になる。Gx,Gyも図に記載されていないが、印加されたパルス面積 の総和が0になるように、Gzのリワインダと同じ時間上に、リワインダパルスを挿入し てもよい。

20

30

10

なお、実空間における撮像領域の座標をピクセルで表す場合、 k 空間の座標の単位は「 1 / ピクセル」となる。ここで、例えば、処理回路131のシステム制御機能1311又 は Spoke算出機能1321が、ピクセルとcmとの変換式を用いて、 k 空間の座標の 単位が「1 / cm = cm<sup>-1</sup>」となるように変換してもよい。

【0069】

例えば、実空間において128×128ピクセルの画像であれば、 k 空間では1ピクセルが「1/128」である。ここで実空間において128×128ピクセルが10×10 c m である場合、変換式として「cm/ピクセル」の比率を求めることにより、実空間では、1ピクセルが10/128 c m に変換できるので、 k 空間の単位を「1/cm」に変換、すなわち k 空間の単位を(128/10) c m<sup>-1</sup> と変換できる。これにより、変換後の値を用いれば、例えば傾斜磁場G<sub>x</sub>、G<sub>y</sub>及びG<sub>z</sub>を掛ける際に値をそのまま利用することができるといった実益がある。

[0070]

また、算出される振幅は、各サブパルスの振幅の相対量を表す指標であるため、無次元 の値である。よって、各サブパルスのフリップ角を求める場合は、例えば処理回路131 が、システム制御機能1311により、所望のフリップ角×(RFサブパルスの振幅/R Fサブパルスの振幅の総和)を計算すればよい。例えば、5本のSpokeにそれぞれ対 応する第1のRFパルスから第5のRFパルスを印加することにより、フリップ角を90 度とする場合を想定する。第1のRFパルスのフリップ角が知りたい場合は、処理回路1 31が、システム制御機能1311により、第1のRFパルスから第5のRFパルスまで の振幅をそれぞれA1~A5とすると、90度×(A1/(A1+A2+A3+A4+A 5))を計算すればよい。

[0071]

なお、フィッティングに用いる多項式関数は、撮像領域において得られる B<sub>1</sub> 感度マッ プの状態に応じて使い分けてもよい。多項式関数の使い分けの一例について、図 8 A 及び 図 8 B を参照して説明する。

【0072】

図8Aは、頭部のB<sub>1</sub>感度マップの一例を示す。B<sub>1</sub>感度マップの×y平面において中 心部分がB<sub>1</sub>強度が強く、中心から外側向かって同心円状に減少していく強度分布となっ ており、原点中心に対称性を有する。

【0073】

このような対称性を有する B<sub>1</sub> 感度マップの場合、 k 空間の k<sub>x</sub>軸上、 k<sub>y</sub>軸上に位置 する Spokeにより、 B<sub>1</sub> 感度マップのムラを対称に補正することができる。よって、 関連づけられる多項式関数としては、 x<sup>2</sup>, y<sup>2</sup>, x, y及び定数の項を有する多項式関 数 (P=ax<sup>2</sup> + by<sup>2</sup> + cx + dy + e)をフィッティングに用いればよい。 【0074】

一方、図8Bは、腹部のB1感度マップの一例を示す。このように、原点から非対称の 構成である場合、複雑な補正が必要であり、k空間のkx軸上、ky軸上ではない位置に Spokeが位置する必要がある。よって、「xy」の項を有する上述の式(1)の多項 式関数をフィッティングに用いて計算すればよい。

【0075】

すなわち、撮像領域の B<sub>1</sub> 感度マップが対称であるか非対称であるかに応じて、フィッ ティングに用いる多項式関数を使い分け、対称性がある場合は、項数を減らすことができ るので、多項式関数と Spokeの関係式との関連づけが簡易となる。よって、当該関連 づけからk空間上の位置、振幅及び位相を決定するための解析が簡易化できる。 【0076】

具体的な処理としては、例えば、記憶装置129等に上述した2種類の多項式関数に関するアルゴリズムを格納する。処理回路131のシステム制御機能1311が、撮像領域のB<sub>1</sub>感度マップが対称であるか非対称であるかを判定する。B<sub>1</sub>感度マップが対称である場合、処理回路131の関数決定機能1319が、多項式関数(P=ax<sup>2</sup>+by<sup>2</sup>+cx+dy+e)を用いて、B<sub>1</sub>感度マップの逆特性に対してフィッティングすればよい。 -方、B<sub>1</sub>感度マップが非対称である場合、処理回路131の関数決定機能1319が、多項式関数(P=ax<sup>2</sup>+by<sup>2</sup>+cx+dy+exy+f)を用いて、B<sub>1</sub>感度マップの逆特性に対してフィッティングすればよい。

また、用いられる多項式関数の次元や項数に合わせ、処理回路131のSpoke算出 機能1321が、多項式関数に関連づけるSpokeの関係式を使い分ける。 【0078】

なお、 B<sub>1</sub> 感度マップが対称であるときに用いる多項式関数(P = a x<sup>2</sup> + b y<sup>2</sup> + c x + d y + e)でフィッティングする場合、例えば、処理回路131のシステム制御機能 1311が、多項式関数の2次関数が上に凸となる場合と、下に凸となる場合とを判定し てもよい。2次関数が下に凸となる場合は、処理回路131のSpoke算出機能132 1が、Spokeの関係式において、位相を ずらしたものを用いる。これにより、フィ ッティングに用いた多項式関数とSpokeの関係式とを解析において最適に関係づける ことができる。

【0079】

また、上述の式(1)に示す多項式関数 P を用いて、多項式関数 P と S p o k e の関係 式とを解析的に解く場合、振幅がマイナス(負)になる等、非現実的な数値が解として出 てくる場合も考えられる。よって、処理回路131の S p o k e 算出機能1321が、解 として現実的な値が得られるように、原点を通る中心の S p o k e の振幅が負にならない よう k 空間座標の条件式を設定してもよい。

【0080】

さらに、上述の式(1)に示す多項式関数 P を用いる場合、判別式を用いて、2次曲線 (双曲線、楕円、放物線等)の性質を利用してもよい。例えば、処理回路131のS p o k e 算出機能1321が、2次曲線の焦点や軸を基準として、 k 空間上の位置及び位相を 設定してもよい。

【0081】

また、上述の式(1)に示す多項式関数 P を用いる際、処理回路131の S p o k e 算 出機能1321が、S p o k e の関係式における位相が零度よりも閾値以上ずれる場合、 関係式を解析的に解く場合に、S p o k e の関係式で用いる近似方法を変更してもよい。 10

20



[0082]

例えば、 が零度から閾値未満のずれである、例えば零度に近づけたい場合は、「co s = 1 - <sup>2</sup> / 2」と近似されればよく、 が零度から閾値以上のずれである、例えば に近づけたい場合は、「cos = -1 + ( - )<sup>2</sup> / 2」と近似されればよい。 [0083]

(13)

次に、Spokeの適用前後におけるB1感度マップの一例について図9A及び図9B を参照して説明する。

[0084]

図9Aは、Spoke適用前の腹部のB」感度マップを示す。図9Bは、Spoke適 10 用後の腹部のB1感度マップを示す。図9A及び図9B共に、縦軸はy方向のピクセル値 、横軸は×方向のピクセル値である。また、磁場の強度分布をグラデーションで示す。

[0085]

図9Aに示すように、Spoke適用前のB1感度マップには、磁場の強度にムラが生 じているため、磁場分布が不均一である。

[0086]

一方、図9Bに示すように、Spoke適用後のB1感度マップには、磁場の強度にム ラはなく、均一となる。

[0087]

以上に示した本実施形態によれば、B₁感度マップの逆特性を多項式関数でフィッティ 20 ングし、当該多項式関数とSpokeの関係式とを関連づけて解析的に解く。これにより 、Spoke技術で使用する、RFパルスのk空間上の位置、振幅及び位相を一意に算出 できる。よって、算出されたk空間上の位置、振幅及び位相に基づいたRFパルスを用い ることで、RFパルスにより生成されるB」分布を、B」感度マップの逆特性に高精度に 近づけることができる。結果として、B<sub>1</sub>感度マップの不均一性を簡易かつ高精度に改善 することができる。

[0088]

なお、本実施形態では、取得したB→感度マップの逆特性に応じてSpokeを決定し ているが、被検体の年齢、性別、体重、撮像部位等の撮像条件に対応して、適用すべきS pokeが予め決定されてもよい。

[0089]

例えば、撮像条件と適用すべきSpokeの関係式との対応関係を予めテーブルとして 用意し、当該テーブルを、例えば記憶装置129等に格納する。撮像領域が決定された場 合、処理回路131のSpoke算出機能1321が、被検体の撮像条件に基づいて、テ ーブルを参照して適用すべきSpokeの関係式を決定する。決定されたSpokeのト ラジェクトリに沿って R F パルスが印加され、本スキャンが実行されればよい。  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 9 & 0 \end{bmatrix}$ 

これにより、撮像の都度Spokeを決定する処理を行うことなく、Spokeの生成 処理に係る時間を短縮できる。

[0091]

また、上述のフィッティングに用いる多項式関数及びSpokeの関係式とは、共に2 次元の関数で対応付けを行っているが、これに限らず、多項式関数とSpokeの関係式 との次元数が一致していれば、より高次元の関数を用いてもよい。例えば、Spokeの 関係式は、コサイン関数のテイラー展開でより高次元の関数、具体的には(2n-1)次 元の関数として表せる。よって、フィッティングに用いる多項式関数とSpokeの関係 式とを2次元よりも高次元の多項式とすることで、2次元の場合と同様の処理が可能であ りながら、フィッティング関数によるB1感度マップの再現性をより高めることができる 。結果として、より高精度にB1感度マップの不均一性を改善できる。

[0092]

上述した実施形態の中で説明した処理回路131の各機能は、ソフトウェアであるプロ グラムに基づいて実行されることが可能である。処理回路131の各機能は、コンピュー 50

タに実行させることのできるプログラムとして、磁気ディスク(フレキシブルディスク、 ハードディスク等)、光ディスク(CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-RO M、DVD±R、DVD±RW等)、半導体メモリ、又はこれに類する記録媒体に記録さ れる。コンピュータ又は組み込みシステムが読み取り可能な記憶媒体であれば、その記憶 形式は何れの形態であってもよい。このとき、コンピュータは、この記録媒体からプログ ラムを読み込み、このプログラムに基づいてプログラムに記述されている指示をCPUで 実行させれば、上述した処理回路131の各機能を実現することができる。また、記憶媒 体は、コンピュータあるいは組み込みシステムと独立した媒体に限らず、LAN(Loc al Area Network)やインターネット等により伝達されたプログラムをダ ウンロードして記憶又は一時記憶した記憶媒体も含まれる。また、記憶媒体は1つに限ら れず、複数の媒体から、処理回路131の各機能が実行される場合も、実施形態における 記憶媒体に含まれ、媒体の構成は何れの構成であってもよい。

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その 他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の 省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や 要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる

【符号の説明】

【0094】

100・・・磁気共鳴イメージング装置、101・・・静磁場磁石、103・・・傾斜磁 場コイル、105・・・傾斜磁場電源、107・・・寝台、109・・・寝台制御回路、 111・・・ボア、113・・・送信コイル、115・・・送信回路、117・・・受信 コイル、119・・・受信回路、121・・・シーケンス制御回路、123・・・バス、 125・・・インタフェース回路、127・・・ディスプレイ、129・・・記憶装置、 131・・・処理回路、601・・・Spoke、602・・・トラジェクトリ、107 1・・・天板、1311・・・システム制御機能、1313・・・データ配列機能、13 15・・・画像生成機能、1317・・・逆特性算出機能、1319・・・関数決定機能 、1321・・・Spoke算出機能。

30

20

10

(14)









図5















【図8A】 <sub>図8A</sub>



【図 8 B】

図8B



【図 9 A】





図9B



フロントページの続き

- (72)発明者 内田 大輔
   東京都港区芝浦一丁目1番1号 株式会社東芝内
   (72)発明者 秋田 耕司
  - 東京都港区芝浦一丁目1番1号 株式会社東芝内
  - 審査官 伊藤 昭治
- (56)参考文献 特開2015-019813(JP,A)
  国際公開第2013/115400(WO,A1)
  SAEKHO, Suit, Fast-kz Three-Dimensional Tailored Radiofrequency Pulse for Reduced B1 I
  nhomogeneity, Magnetic Resonance in Medicine, 2006年, Vol. 55, Issue 4, pp. 719 724

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A 6 1 B 5 / 0 5 5 G 0 1 N 2 4 / 0 8